

Председателю диссертационного
совета Д 002.034.01
на базе ФГБУН ИАП РАН
д.т.н., проф. Курочкину В.Е.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Уважаемый Владимир Ефимович!

Настоящим подтверждаю свое согласие выступить в качестве официального оппонента по диссертации Дворцова Дениса Валерьевича на тему «Одночастотные лазерные диоды с длинами волн 630 – 660 нм для интерференционных измерений» по специальности 01.04.01 — «Приборы и методы экспериментальной физики», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук.

О себе сообщаю:

Фамилия Имя Отчество оппонента	Пихтин Никита Александрович
Шифр и наименование специальностей, по которым защищена диссертация	01.04.10 - физика полупроводников
Ученая степень и отрасль науки	Кандидат физико-математических наук
Ученое звание	-
Полное наименование организации, являющейся основным местом работы оппонента	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
Занимаемая должность, с указанием структурного подразделения	Старший научный сотрудник, и.о. заведующего лабораторией «Полупроводниковой люминесценции и инжекционных излучателей»
Почтовый индекс, адрес	194021 С.Петербург, ул. Политехническая д. 26
Телефон	8-921-303-3739
Адрес электронной почты	nike@hpld.ioffe.ru

**Список основных публикаций по теме рецензируемой диссертации
в журналах, рекомендованных ВАК за последние 5 лет:**

1. Веселов, ДА; Шашкин, ИС; Бахвалов, КВ; Лютецкий, АВ; Пихтин, НА; Растегаева, МГ; Слипченко, СО; Бечвай, ЕА; Стрелец, ВА; Шамахов, ВВ; Тарасов, ИС «К вопросу о внутренних оптических потерях и токовых утечках в лазерных гетероструктурах на основе твердых растворов AlGaInAs/InP»
Авторы: 2016, ФТП, т.50, 9 страницы: 1247-1252
2. Золотарев, ВВ; Лешко, АЮ; Лютецкий, АВ; Николаев, ДН; Пихтин, НА; Подоскин, АА; Слипченко, СО; Соколова, ЗН; Шамахов, ВВ; Арсентьев, ИН; Вавилова, ЛС; Бахвалов, КВ; Тарасов, ИС «Полупроводниковые лазеры с внутренней селекцией излучения» 2013, ФТП, т.47, 1 страницы: 124-128 ИФ 0,649
<http://journals.ioffe.ru/ftp/2013/01/page-110.html.ru>
3. Шашкин, ИС; Винокуров, ДА; Лютецкий, АВ; Николаев, ДН; Пихтин, НА; Растегаева, МГ; Соколова, ЗН; Слипченко, СО; Станкевич, АЛ; Шамахов, ВВ; Веселов, ДА; Бондарев, АД; Тарасов, ИС «Температурная делокализация носителей заряда в полупроводниковых лазерах ($\lambda=1010-1070$ нм)» 2012, ФТП, т.46, 9 страницы: 1230-1233 ИФ 0,649
<http://journals.ioffe.ru/ftp/2012/09/page-1230.html.ru>
4. Винокуров, ДА; Капитонов, ВА; Лютецкий, АВ; Николаев, ДН; Пихтин, НА; Слипченко, СО; Станкевич, АЛ; Шамахов, ВВ; Вавилова, ЛС; Тарасов, ИС «Лазерные диоды, излучающие на длине волны 850 нм, на основе гетероструктур AlGaAsP/GaAs» 2012, ФТП, т.46, 10 страницы: 1344-1348 ИФ 0,649
<http://journals.ioffe.ru/ftp/2012/10/page-1344.html.ru>
5. Slipchenko, S.O.; Podoskin, A.A.; Soboleva, O.S.; Pikhtin, N.A.; Bagaev, T.A.; Ladugin, M.A.; Marmalyuk, A.A.; Simakov, V.A.; Tarasov, I.S. «Spatial dynamics of high current turn-on in low-voltage AlGaAs/GaAs phototransistors» 2016, J. Appl. Phys., v.119, 12 ArtNo: #124513, IF 2.101
6. Podoskin A.A., Soboleva O.S., Zakharov M.S., Veselov D.A., Zolotarev V.V., Pikhtin N.A., Tarasov I.S., Bagaev T.A., Ladugin M.A., Marmalyuk A.A. "Optical feedback in 905 nm power laser-thyristors based on AlGaAs/GaAs heterostructures.", 2015, Semiconductor Science and Technology – V. 30 – № 12, 125011, IF 2.098
<http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0268-1242/30/12/125011/pdf>
7. Sokolova Z.N., Pikhtin N. A., Tarasov I. S., Asryan S.A. "Comparative analysis of the effects of electron and hole capture on the power characteristics of a semiconductor quantum-well laser.", 2015, Semiconductors, V. 49 – № 11 – pp.: 1506-1510.
<http://link.springer.com/article/10.1134%2FS1063782615110202>, IF 0.701
8. Slipchenko S.O., Podoskin, A.A.; Rozhkov, AV; Pikhtin, NA; Tarasov, IS; Bagaev, TA; Ladugin, MA; Marmalyuk, AA; Padalitsa, AA; Simakov, VA, "High-power laser thyristors with high injection efficiency ($\lambda = 890-910$ nm)", 2015, IEEE Photonics Technol. Lett., V.27, № 3 pp.: 307-310, IF 2.011

<http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?reload=true&arnumber=6960816>

9. Slipchenko S.O., Podoskin A.A., Vinokurov, D.A., Bondarev A. D., Kapitonov V. A., Pikhtin N. A., Kop'ev P. S., Tarasov I. S. "AlGaAs/GaAs diode lasers (1020-1100 nm) with an asymmetric broadened single transverse mode waveguide" 2013, Semiconductors – V. 47 – № 8 – pp.: 1079-1083., IF 0.701
<http://link.springer.com/article/10.1134%2FS1063782613080186>

10. Slipchenko, S.O., Podoskin, A.A., Rozhkov, A.V., Pikhtin, N.A., Tarasov, I.S., Bagaev, T.A., Zverkov, Mikhail V., Konyaev, V.P., Kurniavko, Y.V., Ladugin, M.A., Marmalyuk, A. A., Padalitsa, A.A., Simakov, V.A. "High-Power Pulse Semiconductor Laser-Thyristor Emitting at 900-nm Wavelength.", 2013, IEEE Photonics Technology Letters – V. 25 – № 7 – pp.: 1664-1667., IF 2.011

<http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?reload=true&arnumber=6557483>

11. Sokolova Z.N., Bakhvalov K.V., Lyutetskiy A.V., Pikhtin N.A., Tarasov I.S., Asryan L.V., "Method for determination of capture velocity of charge carriers into quantum well in semiconductor laser.", 2015, Electron. Lett., v.51, 10 pp.:780-782, IF 0.854

<http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?reload=true&arnumber=7105464>

12. Veselov D.A., Pikhtin N.A., Lyutetskiy A.V., Nikolaev D.N., Slipchenko S.O., Sokolova Z.N., Shamakhov V.V., Shashkin I.S., Kapitonov V.A., Tarasov I.S., "Effect of laser cavity parameters on saturation of light-current characteristics of high-power pulsed lasers." 2015, Quantum Electron., v.45, 7 pp.: 597-600, IF 0.978

<http://iopscience.iop.org/article/10.1070/QE2015v045n07ABEH015742/meta>

Не являюсь членом экспертного совета ВАК. Даю согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных.

Н.А. ПИХТИН

11.09.2017

